

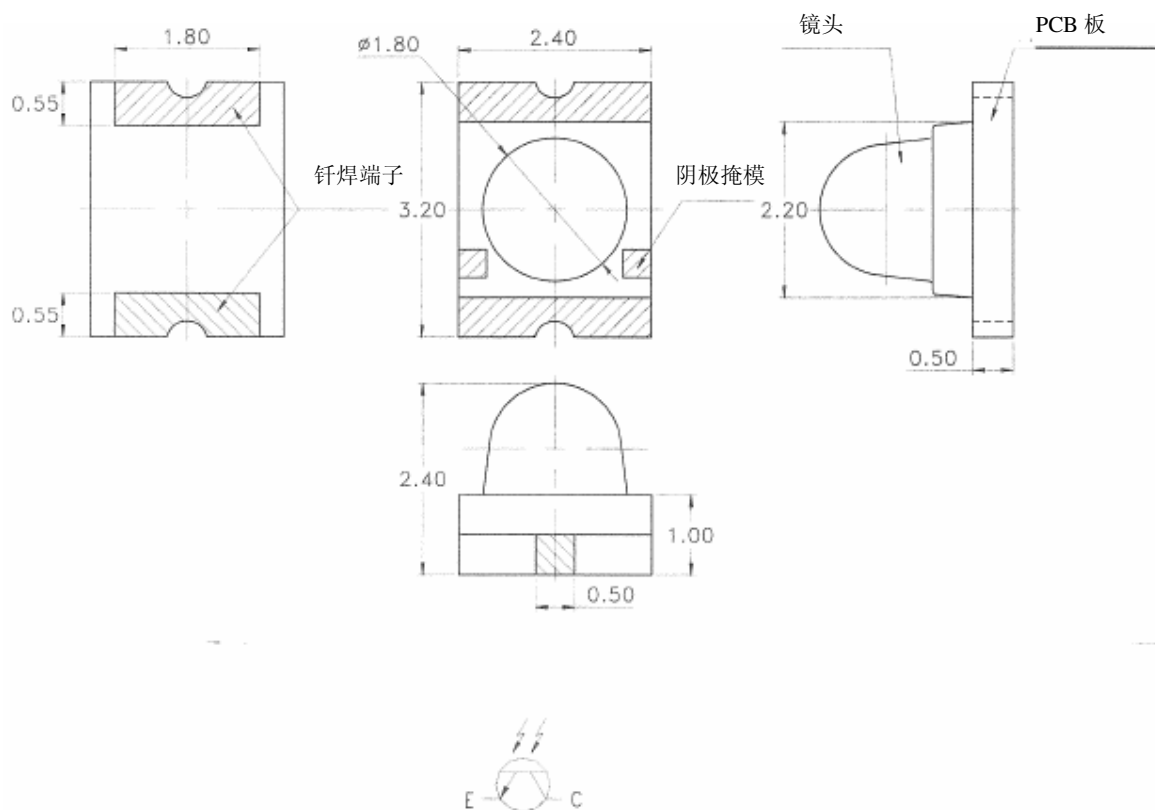
霍尼韦尔 SMD2441

硅光电晶体管

特点

- * 封装在直径为 7" 的卷轴中的 8mm 带上。
- * 与红外线和蒸气相回流焊剂的过程兼容。
- * EIA（电子工业联合会）标准封装

封装件尺寸



注:

1. 所有尺寸为毫米(英寸)。
2. 公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ (.004"), 除非另有说明。
3. 技术规格更改不另行通知。

霍尼韦尔 SMD2441
硅光电晶体管

绝对最大额定值，TA=25°C 时

参数	最大额定值	单位
功耗	100	mW
集电极-发射极电压	30	V
发射极-集电极电压	5	V
工作温度范围	-40°C 至+85°C	
储存温度范围	-55°C 至+100°C	
波形焊接温度	260°C，5 秒	
红外回流条件	260°C，5 秒	

电气/光学的特性，TA=25°C 时

参数	符号	最小值	标准值	最大值	单位	测试条件
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	30	-	-	V	$I_C=1\text{mA}$ $E_e=0\text{ mW/cm}^2$
发射极-集电极击穿电压	$V_{(BR)ECO}$	5	-	-	V	$I_E=100\mu\text{A}$ $E_e=0\text{ mW/cm}^2$
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$	-	-	0.4	V	$I_C=100\mu\text{A}$ $E_e=1\text{mW/cm}^2$
上升时间	T_r	-	10	-	μS	$C=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$ $R_L=1\text{k}\Omega$
下降时间	T_f	-	15	-	μS	
集电极暗电流	I_{CEO}	-	-	100	nA	$V_{CE}=10\text{V}$ $E_e=0\text{ mW/cm}^2$
导通状态的集电极电流	$I_{C(ON)}$	2.0	5	-	mA	$V_{CE}=10\text{V}$ $E_e=1\text{ mW/cm}^2$ $\lambda=940\text{nm}$

霍尼韦尔 SMD2441
硅光电晶体管

典型电气/光学特性曲线
(25°C 环境温度, 除非另有说明)

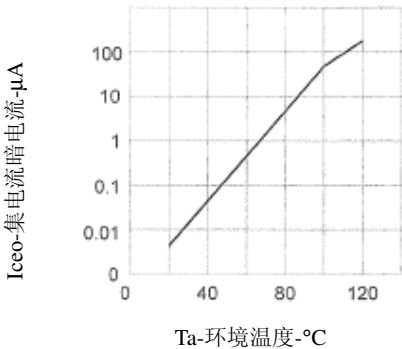


图 1. 集电极暗电流与环境温度的关系

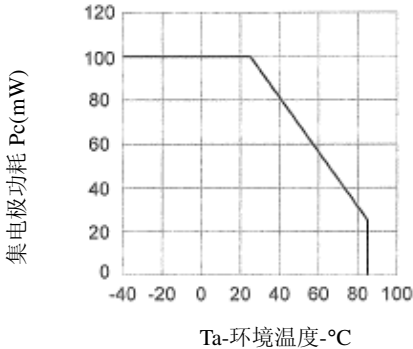


图 2. 集电极功耗与环境温度的关系

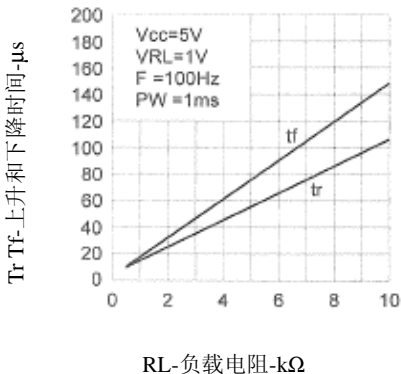


图 3. 上升和下降时间与负载电阻的关系

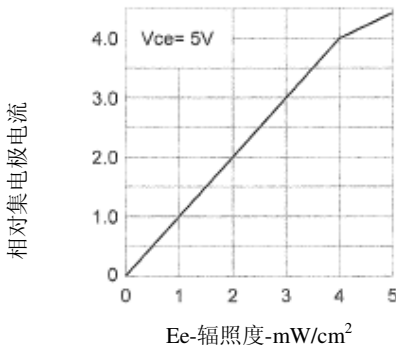


图 4. 相对集电极电流与辐照度的关系

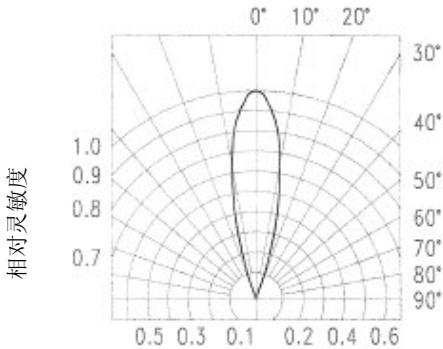
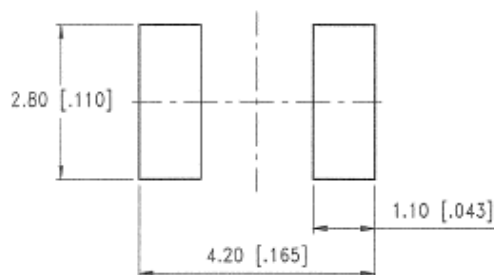


图 5. 灵敏度图

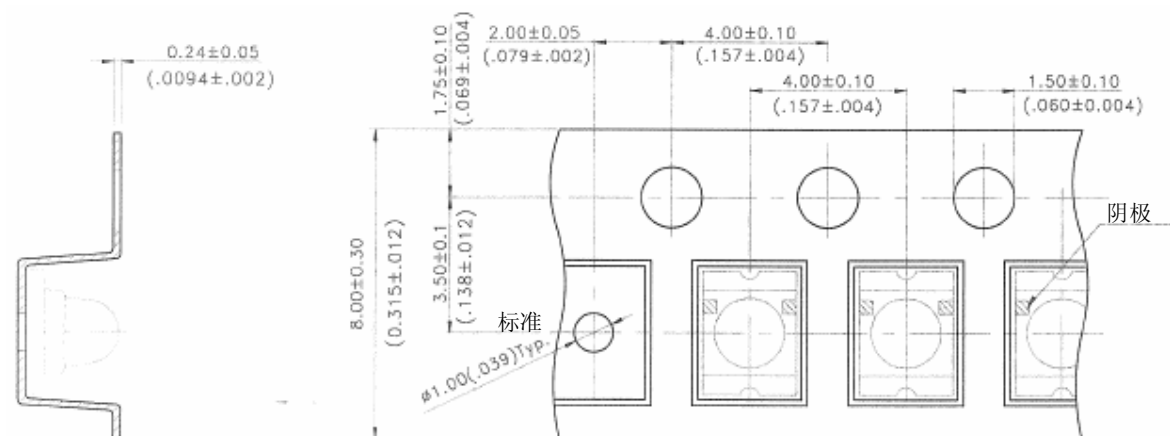
霍尼韦尔 SMD2441

硅光电晶体管

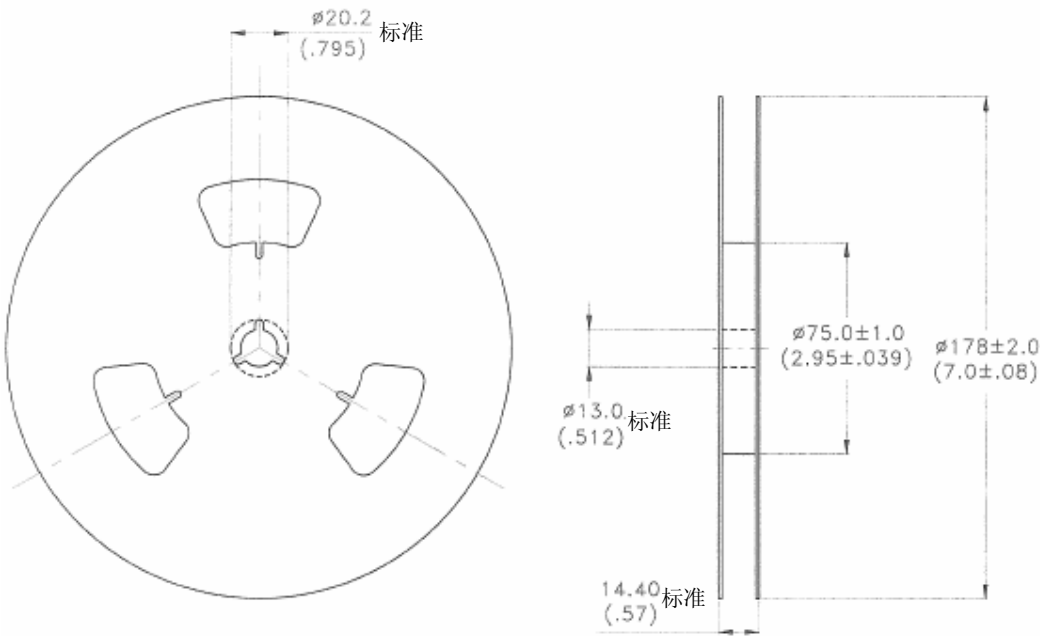
建议焊接的垫片尺寸



帶子和卷軸的封装尺寸



霍尼韦尔 SMD2441
硅光电晶体管



注:

1. 所有尺寸为毫米(英寸)。
2. 空的部件袋用顶部封带密封。
3. 7" 卷轴-每卷轴 1500 件。
4. 连续缺少零件的最大数目是 2 个。
5. 符合 ANSI / EIA 481 - 1 - A -1994 的技术规格。